DIALOG(R) File 352: Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

XRPX Acc No: N98-156539

Active matrix LCD device e.g. for TV, PC - has protrusions of different height which are formed on one end of each spacer so that sum total of each protrusion and corresponding spacer are same

Patent Assignee: TOSHIBA KK (TOKE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 10048640 A 19980220 JP 96200585 A 19960730 199818 B

Priority Applications (No Type Date): JP 96200585 A 19960730

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 10048640 A 7 G02F-001/1339

Abstract (Basic): JP 10048640 A

The device has a first substrate on which multiple signal lines and scanning lines are arranged in the shape of a matrix. A switching element (32) is formed at the intersection point of signal line and scanning line. A second substrate (13) is arranged oppositely to the first substrate with a liquid crystal arranged between the first and second substrates.

A set of spacers (14-1 - 14-3) are formed in the second substrate which project towards the first substrate. A set of protrusions (33-1 - 33-3) of different heights are formed at the end of each spacers so that the total height of all the protrusion and corresponding spacers are the same.

ADVANTAGE - Prevents display irregularity and improves display quality.

Dwg. 1/8

Title Terms: ACTIVE; MATRIX; LCD; DEVICE; TELEVISION; PROTRUDE; HEIGHT; FORMING; ONE; END; SPACE; SO; SUM; TOTAL; PROTRUDE; CORRESPOND; SPACE

Derwent Class: P81; U14

International Patent Class (Main): G02F-001/1339
International Patent Class (Additional): G02F-001/136

File Segment: EPI; EngPI

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05765540 ** Image available ** ACTIVE MATRIX TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

10-048640 [JP 10048640 A]

PUBLISHED:

February 20, 1998 (19980220)

INVENTOR(s): TAKEBAYASHI KISAKO

HANAZAWA YASUYUKI

APPLICANT(s): TOSHIBA CORP [000307] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

08-200585 [JP 96200585]

FILED:

July 30, 1996 (19960730)

INTL CLASS:

[6] G02F-001/1339; G02F-001/136

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD: RO11 (LIQUID CRYSTALS); RO96 (ELECTRONIC MATERIALS -- Glass

Conductors)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an active matrix type liquid crystal display device which maintains the specified spacing between a first substrate and a second substrate and eliminates unequal display.

SOLUTION: Color filters 13 of colored layers 13R, 13G, 13B of red, green and blue are formed on a counter substrate 15 and spacers 14(sub 1), 14(sub 2), 14(sub 3) varying in height are formed by using two colors among these colored layers 13R, 13G, 13B. Projections 33(sub 1), 33(sub 2), 33(sub 3) are formed to face these spacers 14(sub 1), 14(sub 2), 14(sub 3) by using semiconductor layers 25 of thin-film transistors(TFTs) 32, etching protective layers 26, amorphous silicon layers 27, semiconductor layer parts 25a corresponding to signal lines 31, etching protective layer parts 26a, amorphous silicon layer parts 27a and signal line layer parts 31a on a matrix array substrate 34. The total heights of the spacers 14(sub 1). 14(sub 2), 14(sub 3) and the projections 33(sub 1), 33(sub 2), 33(sub 3) are equaled. The equal heights are thus obtained with both. A cell gap is made uniform and the display grade is improved.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-48640

(43)公開日 平成10年(1998) 2月20日

(51) Int.Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
G02F	1/1339	500		G02F	1/1339	500	
	1/136	500			1/136	500	

審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全 7 頁)

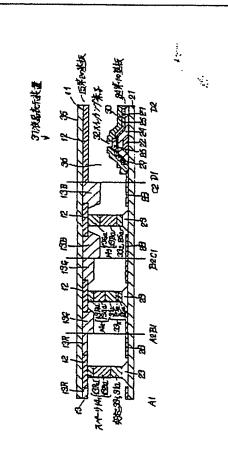
(21)出願番号	特顯平8-200585	(71)出願人	000003078		
			株式会社東芝		
(22)出顯日	平成8年(1996)7月30日		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地		
		(72)発明者	竹林 希佐子		
			神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会		
			社束芝樹浜事業所内		
		(72)発明者	花澤 康行		
			神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会		
			社束芝横浜事業所内		
		(74)代理人	弁理士 樺澤 裏 (外2名)		

(54) 【発明の名称】 アクティブマトリクス型液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 第1の基板および第2の基板の間隔を一定に して表示むらをなくしたアクティブマトリクス型液晶表 示装置を提供する。

【解決手段】 対向基板15上に赤、緑および青色の着色 層13R , 13G , 13B のカラーフィルタ13を形成するとと もに、これら着色層 I3R 、 I3G 、 I3B のうち 2 色を用い て高さが異なるスペーサ141, 142, 143 を形成する。 スペーサ141 , 142 , 143 に対向してマトリクスアレイ 基板34に、薄膜トランジスタ32の半導体層25、エッチン グ保護層26、アモルファスシリコン層27、信号線31に対 応する半導体層部25a、エッチング保護層部26a、アモ ルファスシリコン層部27a 、信号線層部31a を用いて、 突起331、332、333を形成する。対向するスペーサ14 1 、142 、143 および突起331 、332 、333 の合計高さ は等しくなり、いずれも等しい高さとなる。セルギャッ ブが均一になり、表示品位が向上する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の信号線および複数の走査線をマトリクス状に配置しこれら信号線および走査線の各交差部にスイッチング素子を形成した第1の基板と、この第1の基板に対向して設けられ対向電極を有する第2の基板と、前記第1の基板および前記第2の基板の少なくとも一方上に形成された高さの異なるスペーサと、前記スペーサを介した第1の基板および第2の基板間に挟持された液晶とを具備したアクティブマトリクス型液晶表示装置において、

前記スペーサの高さに対応して前記第1の基板上に複数 の異なる高さの突起を形成し、この対応した高さの突起 上にスペーサを設置してスペーサおよび突起を加えた高 さをそれぞれほぼ同一高さとすることを特徴とするアク ティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項2】 スペーサは、第1の基板および第2の基板の少なくとも一方上に形成された着色層を2色以上重ねて形成したことを特徴とする請求項1記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項3】 スイッチング素子は、複数の膜で形成された薄膜トランジスタで、

突起は、この薄膜トランジスタを構成する膜の少なくとも一部で構成されたことを特徴とする請求項1または2 記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項4】 突起は、複数の膜で形成され、下層の膜が上層の膜よりも大きいことを特徴とする請求項1ないし3いずれか記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項5】 突起は、絶縁膜および半導体膜の少なく ともいずれかを有することを特徴とする請求項1ないし 4いずれか記載のアクティブマトリクス型液晶表示装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示むらをなくしたアクティブマトリクス型液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピューターを中心とする情報 機器分野およびテレビなどを中心とする映像機器分野に おいて、高精細なアクティブマトリクス型の液晶表示装 置が開発されている。

【0003】そして、このアクティブマトリクス型液晶 表示装置は大きくはアレイ基板、このアレイ基板に対向 した対向基板、および、アレイ基板および対向基板に挟 持された液晶層を備えている。また、アレイ基板上には マトリクス状に信号線および走査線が形成され、これら 信号線および走査線の交点に対応して画素電極およびこ の画楽電極を制御するアクティブ楽子が設けられてい る。一方、対向基板上には対向電極とRGBの着色層を 有するカラーフィルタが形成されている。また、これら アレイ基板および対向基板間にはこれらアレイ基板および対向基板の距離を一定に保つためのスペーサが設置されている。

【0004】そして、従来、スペーサとしては粒径の均 ーなプラスチックビーズが用いられている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このようにプラスチックビーズをスペーサとすると、プラスチックビーズの周辺に光漏れによりコントラストが低下したり、散布むらにより表示むらが生ずることがある問題を有している。

【0006】そこで、これらコントラストの低下あるいは表示むらを防止するものとして、カラーフィルタの着色層を重ねて注状のスペーサを非画素部のみに均等に設置する構成が考えられる。

【0007】すなわち、図8に示すように、絶縁性透明 基板1上に、遮光層2を所定間隔で形成し、これら遮光 層2間に、赤色の着色層3R、緑色の着色層3Gおよび青色 の着色層3Bを配設してカラーフィルタ3を形成する。また、これら着色層3R、3G、3Bを形成する際に、遮光層2 上に注状のスペーサ41、42、43を形成する。なお、スペーサ41は隣接する赤色の着色層3Rおよび春色の奇色層3Rおよび春色の表ペーサ部4Rおよび青色のスペーサ部4Bにて形成され、スペーサ42は隣接する赤色の着色層3Rおよび緑色の着色層3Gおよび青色のスペーサ部4Gにて形成され、スペーサ43は隣接する緑色の着色層3Gおよび青色のスペーサ部4Gにて形成され、対向基板5が形成されている。

【0008】一方、赤色の春色層3R、緑色の春色層3Gおよび青色の春色層3Bは、それぞれ異なる最適な膜厚で形成されているため、スペーサ41、42、43 はそれぞれ高さが異なってしまい、アレイ基板および対向基板間に均一なセルギャップが得られず表示むらが発生するおそれがある問題を有している。

【0009】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもので、第1の基板および第2の基板の間隔を一定にして表示むらをなくしたアクティブマトリクス型液晶表示装置を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、複数の信号線 および複数の走査線をマトリクス状に配置しこれら信号 線および走査線の各交差部にスイッチング案子を形成し た第1の基板と、この第1の基板に対向して設けられ対 向電極を有する第2の基板と、前記第1の基板および前 記第2の基板の少なくとも一方上に形成された高さの異 なるスペーサと、前記スペーサを介した第1の基板および第2の基板間に挟持された液晶とを具備したアクティ プマトリクス型液晶表示装置において、前記スペーサの 高さに対応して前記第1の基板上に複数の異なる高さの 突起を形成し、この対応した高さの突起上にスペーサを 設置してスペーサおよび突起を加えた高さをそれぞれほ ぼ同一高さとするもので、スペーサの高さに対応して第 1の基板に突起を設け、スペーサおよび突起を加えた高 さをそれぞれほぼ同じ高さとすることにより、第1の基 板および第2の基板間を一定に保つことができ、表示む らがなくなる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明のアクティブマトリクス型液晶表示装置の一実施の形態を図面を参照して説明する。

【0012】図1に示すように、絶縁性透明基板11上に 膜厚1.0 μ mに遮光層12がマトリクス状に形成され、このマトリクス状の遮光層12で囲われた部分に、 膜厚1.5 μ mの赤色の著色層13R 、 膜厚1.8 μ mの緑色の著色層13G および膜厚2.0 μ mの音色の著色層13B がそれぞれ形成されてカラーフィルタ13を形成している。

【0013】また、赤色の着色層13R の間の遮光層12上にはスペーサ14 $_1$ が形成され、緑色の着色層13G の間にはスペーサ14 $_2$ が形成され、骨色の着色層13B の間の遮光層12上にはスペーサ14 $_3$ が形成されている。そして、それぞれのスペーサ14 $_1$ 、14 $_2$ 、14 $_3$ は、底面が15 $_4$ m×15 $_4$ mの正方形状で、スペーサ14 $_1$ は腹厚1.5 $_4$ mの赤色の着色層部13Raおよび膜厚2.0 $_4$ mの青色の着色層部13Baにより形成されて高さが3.5 $_4$ mで、スペーサ14 $_2$ は膜厚1.5 $_4$ mの赤色の着色層部13Raおよび膜厚1.8 $_4$ mの緑色の着色層部13Gaにより形成されて高さが3.3 $_4$ mで、スペーサ14 $_3$ は腹厚1.8 $_4$ mの緑色の着色層部13Gaおよび膜厚2.0 $_4$ mの母色の着色層部13Baにより形成されて高さが3.8 $_4$ mである。なお、いずれの場合にも、スペーサ14 $_1$ 、14 $_2$ 、14 $_3$ は、表示に影響を与えない遮光層12上に形成されている。

【0014】そして、これらの表面に「TOなどの図示しない透明電極を形成するとともに、配向膜を塗布した後にラビング処理して、第2の基板である対向基板15を形成している。

【0015】また、製造に際しては、絶縁性透明基板11上に感光性の黒色樹脂を塗布し、露光、現像、焼成して 膜厚1.0μmの遮光層12を形成する。

【0016】次に、赤色の顔料を分散させた紫外線硬化型アクリル樹脂レジストを塗布し、露光・現像・焼成を行い膜厚1.5μmの赤色の春色層13R およびスペーサ141,142 の奇色層部13Raを形成する。同様の工程を繰り返し、膜厚2.0μmの緑色の奇色層13G およびスペーサ142、143 の奇色層部13Ga、および、膜厚1.8μmの脊色の奇色層13B およびスペーサ141、143 の奇色層部13Baを形成する。すなわち、画素毎にスペーサ141、142、143 の高さが異なる。

【0017】その後、スパッタ法にてITOを成膜して パターニングして図示しない透明電極を形成し、さらに 配向膜を塗布した後ラビング処理して、対向基板15を形 成している。

【0018】また、図1および図2に示すように、絶録 性透明基板21上に、ゲート電極22を形成し、このゲート 電極22にはこのゲート電極22と一体に走査線23が形成さ れ、このゲート電極22上にはゲート絶録膜層24およびア モルファスシリコン(a-Si)の半導体層25が積層形 成されている。また、半導体層25の上部のゲート電極22 の上方には、エッチング保護層26が形成され、半導体層 25の上部のエッチング保護層26の両側にはn+ -a-S iのアモルファスシリコン層27が形成されている。さら に、絶縁性透明基板21上には、ゲート電極22間に位置し て、ITOの画楽電極28がマトリクス状に形成されてい る。また、エッチング保護層26の一端側のアモルファス シリコン層27上には画素電極28に電気的に接続されてソ ース電極29が形成され、エッチング保護層26の他端側の アモルファスシリコン層27上にはドレイン電極30が形成 され、このドレイン電極30にはこのドレイン電極30と一 体の信号線31が走査線23に直交して形成され、走査線23 および信号線31の各交点にスイッチング票子としてのチ ャネル保護型ボトムゲートの薄膜トランジスタ32が形成 される。

【0019】さらに、走査線23上にスペーサ141.1 42 , 143 に対向し同様に底面が15μm×15μmの 正方形状の突起331,332,333 が形成されている。そ して、高さ3. 5μmのスペーサ14₁ に対向する突起33 」はソース電極29およびドレイン電極30を形成する膜厚 5000オングストロームの信号線層部31a にて形成さ れ、高さ3. 3 µ mのスペーサ142 に対向する突起332 は膜厚1000オングストロームの半導体層部25a 、膜 厚1000オングストロームのアモルファスシリコン層 部27a および5000オングストロームの信号線層部31 a の合計膜厚7000オングストロームに形成され、高 さ3. 8μmのスペーサ14g に対向する突起33g は膜厚 2000オングストロームのエッチング保護層部26a で 形成されている。したがって、高さ3.5 µ mのスペー サ141 に膜厚5000オングストコームの突起331 が対 向して合計高さ4. Ομ mになり、高さ3. 3μ mのス ペーサ142 に膜厚7000オングストロームの突起33つ が対向して合計高さ4.0μmになり、高さ3.8μm のスペーサ143 に膜厚2000オングストロームの突起 33g が対向して合計高さ4. 0μmになり、いずれも等 しい高さとなる。なお、画素毎にスペーサ141、142、 143 の高さが異なるため、突起331 . 332 . 333の高さ も同様に画素毎に異なる。

【0020】そして、これらにて第1の基板としてのマトリクスアレイ基板34が形成される。

【0021】また、製造に際しては、ゲート電極22、ゲ

ート絶縁膜層24、半導体層25、アモルファスシリコン層27、エッチング保護層26、ソース電極29およびドレイン電極30の成膜とパターニングを繰り返して、絶縁性透明基板21上に薄膜トランジスタ32が形成される。

【0022】このとき、突起33₁ はドレイン電極30が接続された信号線31とともに信号線層部31a を形成し、突起33₂ は半導体層25とともに半導体層部25a を、アモルファスシリコン層27とともにアモルファスシリコン層部27a を、信号線31とともに信号線層部31a を順次形成することにより形成し、突起33₃ はエッチング保護層26とともにエッチング保護層部26a を形成する。

【0023】その後、配向膜を塗布した後ラビング処理 して、マトリクスアレイ基板34を形成している。

【0024】また、対向基板15およびマトリクスアレイ 基板34を対向させ、図示しないシール材により対向基板 15およびマトリクスアレイ基板34の同囲を封着して液晶 セル35とし、この液晶セル35に液晶36(ZLI-508 0、E. Merck 社製)を注入し、液晶36の層厚 d が 5。 0 μ m のアクティブマトリクス型液晶表示装置37を完成 する。

【0025】そして、このアクティブマトリクス型液晶表示装置37を駆動したところ、スペーサ 14_1 、 14_2 、 14_3 の高低差はマトリクスアレイ基板34上の突起 33_1 、 33_2 、 33_3 で補正されているため均一なセルギャップ、すなわちマトリクスアレイ基板34および対向基板15の距離が得られ、表示むらはみられなかった。また、スペーサ 14_1 、 14_2 、 14_3 を用いたことにより高コントラストであるのはもちろんであるが、着色a13a13a13a13a10 原厚最適化により色合いがよく色純度が高く、明るく透過率の高い良好な表示が得られた。

【0026】次に、他の実施の形態のアクティブマトリクス型液晶表示装置について、図3を参照して説明する。

【0027】この図3に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図1および図2に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置において、スペーサ 14_1 は簡厚0. 8 μ mの赤色の着色層部13Raおよび慎厚1. 1 μ mの音色の奇色層部13Baにより形成されて高さが1. 9 μ m で、スペーサ 14_2 は膜厚0. 8 μ mの赤色の着色層部13Raおよび膜厚0. 9 μ mの緑色の奇色層部13Gaにより形成されて高さが1. 7 μ mで、スペーサ 14_3 は膜厚0. 9 μ mの緑色の奇色層部13Gaおよび膜厚1. 1 μ mの音色の奇色層部13Baにより形成されて高さが2. 0 μ mである

【0028】そして、高さ1、 9μ mのスペーサ141に対向する突起331 は順厚 1000 サングストロームの半導体層部25a および順厚 2000 サングストロームのエッチング保護層部25a に合計順厚 3000 サングストロームに形成され、高さ1、 7μ mのスペーナ142 に対向する突起332 は順厚 5000 オングストロームの信号線

層部31a で形成され、高さ 2.0μ mのスペーサ143 に対向する突起333 は膜厚1000オングストロームの半導体層部25a で形成されている。したがって、高さ 1.9μ mのスペーサ141 に膜厚3000オングストロームの突起331 が対向して合計高さ 2.2μ mになり、高さ 1.7μ mのスペーサ142 に膜厚5000オングストロームの突起332 が対向して合計高さ 2.2μ mになり、高さ 2.0μ mのスペーサ143 に膜厚1000オングストロームの突起333 が対向して合計高さ 2.1μ mになり、いずれもほぼ等しい高さとなる。

【0029】そして、この図3に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置37を駆動したところ、前述の場合と同様に、表示むらが無く良好な表示が得られた。

【0030】なお、この場合スペーサ14₁と突起33₁の合計高さおよびスペーサ14₂と突起33₂の合計高さと、スペーサ14₃と突起33₃の合計高さとの間には、約0.1µmの差異があるが、本実施の形態の液晶表示装置においては、表示むらは観察されなかった。

【0031】また、ツイステッドネマティック(TN)型液晶表示素子においては、通常このギャップ差は好ましくは 0.3μ m未満、さらに好ましくは 0.2μ m以下の範囲であれば許容される。したがって、各スペーサ $14_1.14_2.14_3$ と突起 $33_1.33_2.33_3$ の合計高さをこの範囲内となるように調整することによって、均一な表示が得られる。

【0032】このように、突起 33_1 , 33_2 , 33_3 を構成する膜は自由に組み合わせができるため、スペーサ 14_1 , 14_2 , 14_3 の高さに応じて突起高さを変更することが可能である。

【0033】また、他の実施の形態のアクティブマトリクス型液晶表示装置について、図4を参照して説明する。

【0034】この図4に示すアクティブマトリクス型液 晶表示装置は、図1および図2に示すアクティブマトリ クス型液晶表示装置において、薄膜トランジスタをトッ プゲート型にし、そして、高さ3.5μmのスペーサ14 」に対向する突起331 は膜厚5000オングストローム の信号線層部31a にて形成され、高さ3. 3 μmのスペ ーサ142 に対向する突起332 は膜厚2000オングスト ロームの半導体層部25a および5000オングストロー ムの信号線層部31a の合計膜厚7000オングストロー ムに形成され、高さ3. 8μmのスペーサ143 に対向す る突起333 は膜厚2000オングストロームのアモルフ ァスシリコン層部27a で形成されている。したがって、 高さ3. 5 µ mのスペーサ141 に膜厚5000オングス トロームの突起331 が対向して合計高さ4. 0μmにな り、高さ3. 3 g mのスペーサ14g に膜厚7000オン グストロームの突起 33_2 が対向して合計高さ $4.0 \mu m$ になり、高さ3. 8 µ mのスペーサ143 に膜厚2000 オングストロームの突起33%が対向して合計高さ4.0

μmになり、いずれも等しい高さとなる。

【0035】そして、この図4に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置37を駆動したところ、前述の場合と同様に、表示むらが無く良好な表示が得られた。

【0036】また、このようにボトムゲート型に限らず トップゲート型の場合にも有効である。

【0037】さらに、他の実施の形態のアクティブマト リクス型液晶表示装置について、図5を参照して説明する。

【0038】この図5に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図1および図2に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置において、スペーサ 14_1 , 14_2 , 14_3 は底面を 15μ m× 15μ mの正方形状にしたままで、突起 33_1 , 33_2 , 33_3 の底面を 25μ m× 25μ mの正方形状にしたものである。

【0039】そして、マトリクスアレイ基板34と対向基板15との合わせずれが大きい場合にも、突起突起 33_1 , 33_2 , 33_3 とスペーサ 14_1 , 14_2 , 14_3 とのずれによるスペーサ 14_1 , 14_2 , 14_3 の強度のばらつきがないため表示むらは発生せず、歩留まりが向上した。

【0040】またさらに、他の実施の形態のアクティブマトリクス型液晶表示装置について、図6を参照して説明する。

【0041】この図6に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図1および図2に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置において、スペーサ 14_1 . 14_2 . 14_3 は底面を 15μ m× 15μ mの正方形状にしたままで、突起 33_1 , 33_2 . 33_3 の底面を 10μ m× 10μ mの正方形状にしたものである。

【0042】そして、突起 33_1 、 33_2 、 33_3 のサイズでスペーサ機能としての強度が決まるため、スペーサ141、142 143 との合わせずれが生じた場合にも表示むらは発生しない。また、スペーサ141 142 143 に北ベマトリクスアレイ基板34上の突起 33_1 332 333 の方がパターンニング精度が高く太さのばらつきによるスペーサ141 142 143 の強度のばらつきもないため、図5に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置37 に比べ、歩留まりが向上した。

【0043】そしてまた、他の実施の形態のアクティブマトリクス型液晶表示装置について、図7を参照して説明する。

【0044】この図7に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図5に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置において、突起 33_2 の半導体層部25aの底面を 35μ mの正方形状、アモルファスシリコン層部27aの底面を 25μ mの正方形状、信号線層部31aの底面を 15μ m× 15μ mの正方形状にし、上方に向かうにしたがって径小にしたものである。

【0045】そして、このように突起332を形成して配向膜を塗布しラビング処理したところ、突起サイズが大きい場合にみられる突起332の周辺の配向不良は生じなかった。また、ラビングによる膜はがれも発生せず図5に示す実施の形態のものに比べて歩留まりが向上した。

【0046】上記実施の形態では、マルチギャップ構造の場合について説明したが、柱状あるいはその他のスペーサの高さが一定とならない構成であれば、同様に適用できる。また、工程数を増加させることなく、マトリクスアレイ基板上の突起の高さでマトリクスアレイ基板および対向基板間の間隔を補正することにより均一なセルギャップが得られるだけでなく、スペーサの設計の自由度も広がり、最適設計により表示品位も向上する。

[0047]

【発明の効果】本発明によれば、スペーサの高さに対応して第1の基板上に複数の異なる高さの突起を形成し、この対応した高さの突起上にスペーサを設置してスペーサおよび突起を加えた高さをそれぞれほぼ同一高さとするもので、スペーサの高さに対応して第1の基板に突起を設け、スペーサおよび突起を加えた高さをそれぞれほぼ同じ高さとすることにより、第1の基板および第2の基板間を一定に保つことができ、表示むらを防止でき、表示品位が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のアクティブマトリクス型液晶表示装置の一実施の形態を示す断面図である。

【図2】同上マトリクスアレイ基板を示す平面図である。

【図3】同上アクティブマトリクス型液晶表示装置の他の実施の形態を示す断面図である。

【図4】同上アクティブマトリクス型液晶要示装置のまた他の実施の形態を示す断面図である。

【図5】同上アクティブマトリクス型液晶表示装置のさった他の実施の形態を示す断面図である。

【図6】同上アクティブマトリクス型液晶表示装置のまたさらに他の実施の形態を示す断面図である。

【図7】同上アクティブマトリクス型液晶表示装置のそ してまた他の実施の形態を示す断面図である。

【図8】従来例のアクティブマトリクス型液晶表示装置 の対向基板を示す平面図である。

【符号の説明】

141 、142 、143 スペーサ

15 第2の基板としての対向基板

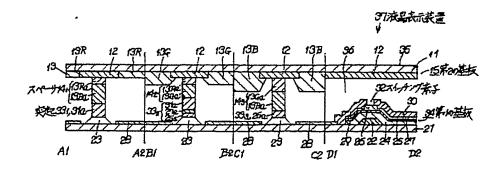
32 スイッチング素子としての薄膜トランジスタ

331 . 332 . 333 突起

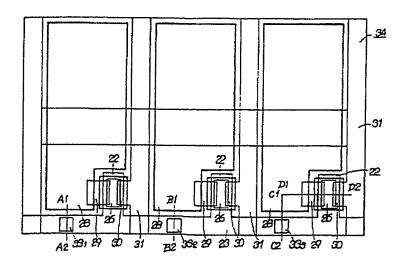
34 第1の基板としてのマトリクスアレイ基板

37 アクティブマトリクス型液晶表示装置

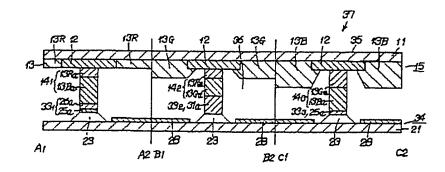
[図1]



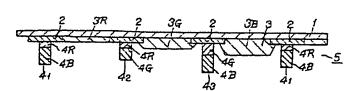
[図2]



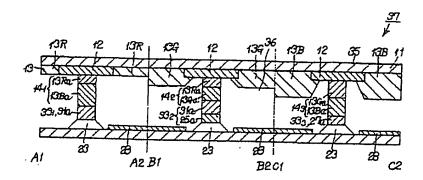
[図3]



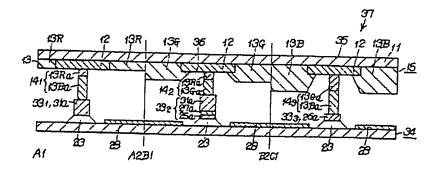
[图8]



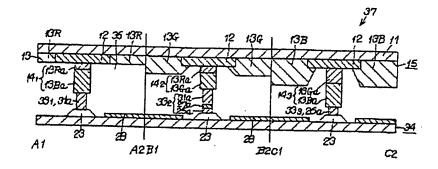
[国4]



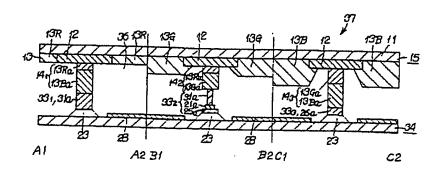
[図5]



[図6]



[图7]



THIS PAGE BLANK (USPTO)